

國立中興大學技術授權遴選廠商公告資料表

公告主旨：國立中興大學技術移轉遴選廠商公告	公告日期：108/04/19
公告編號： 108-013	
<p>內容：國立中興大學技術移轉遴選廠商公告</p> <p>一、技術名稱：磊晶元件的製作方法</p> <p>二、專利資訊：I480926 & US 8, 853, 057 B2</p> <p>三、技術來源：科技部</p> <p>四、技術內容：</p> <p style="padding-left: 2em;">一種製造半導體器件的方法，包括：(a) 形成分層結構，該分層結構包括臨時基板，臨時基板上的多個間隔開的犧牲膜區域，以及犧牲膜區域中的多個谷峰區域；(b) 在犧牲膜區域和谷-峰區域上橫向和磊晶生長磊晶膜層，其中在磊晶膜層和谷-峰區域之間形成間隙；(c) 形成導電層以接觸磊晶膜層；(d) 形成多個凹槽，以將磊晶膜層和導電層分成臨時基板上的多個磊晶結構。</p>	
<p>五、計畫執行機關/系所：材料科學與工程學系、精密工程研究所</p> <p style="padding-left: 2em;">技術發明人：武東星、洪瑞華教授</p>	
<p>六、廠商資格：</p> <p>1、廠商業別：光電產業</p> <p>2、應具備之專門技術：磊晶技術元件製程技術</p> <p>3、應有之機具設備：有機金屬氣相磊晶反應設備、黃光微影設備、金屬蒸鍍/濺鍍設備、化學蝕刻設備等</p> <p>4、應有之研究或技術人員人數：10人</p> <p>5、其他：無</p>	
<p>七、預期利用範圍及產品：發光二極體元件、光電感測器、雷射二極體、...等光電半導體產品。</p>	
<p>八、公開方式：</p> <p>(一) 技術資料於網際網路上公開。</p> <p style="padding-left: 2em;">網址：國立中興大學首頁 http://www.nchu.edu.tw/index1.php</p> <p style="padding-left: 2em;">國立中興大學產學研鏈結中心 http://140.120.49.189/about1.php</p> <p>(二) 逕向國立中興大學產學研鏈結中心葉小姐及黃小姐索取相關資料。</p>	
<p>九、申請方式：</p> <p>(一) 由網際網路下載申請表格，填妥後逕送至國立中興大學產學研鏈結中心。</p> <p>(二) 亦得逕至中興大學索取技術資料及申請表格。</p> <p style="padding-left: 2em;">地點：台中市興大路145號（國農中心大樓2F 234室）</p> <p style="padding-left: 2em;">承辦人員：葉小姐/黃小姐 聯絡電話：(04)22851811#21.20 傳真：(04)22851672</p> <p style="padding-left: 2em;">e-mail：jmine3388@nchu.edu.tw、yenling@nchu.edu.tw</p>	